

型名	社名	用途	構造	チャンネル	最大定格					電気的特性 (Ta=25℃)													
					V*** (V)	区分***	Vgs* (V)	区分*	I* (A)	区分*	Pd/Pch (W)	I _{GSS} (max) (A)	V _{GS} (V)	I _{DSS}		V _{GS(off)} (min) (V)	V _{GS(off)} (max) (V)	V _{DS} (V)	I _D (A)	g _m		V _{DS} (V)	I _D (A)
														(min)	(max)					(min)	(typ)		
SGH5003E	ソニー	MW LN A	GaAsHEMT	N	D	5 DS	-3.5 0	100m	D	340m	-150 μ	-3	15m	100m	2	-0.2	-3	2	500 μ	37m	60m	2	15m
SGH5602E	ソニー	MW LN A	GaAsHEMT	N	D	5 DS	0.4/-3 0	70m	D	340m	-100 μ	-3	12m	70m	2	0.2	-2	2	500 μ	30m	50m	2	10m
SGM2004M	ソニー	UHF LN A	GaAs/MES	N	D	12 DSX	-5	55m	D	150m	-8 μ	-4.5	8m	28m	0	-2.5	-2.5	0	0	11m	15m	5	8m
SGM2006M/P	ソニー	UHF LN A	GaAs/MES	N	D	12 DSX	-5	55m	D	150m	-8 μ	-4.5	10m	35m	0	-2.5	-2.5	0	0	20m	26m	5	10m
TM100-H	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	1200 GDO	70 0	50×2	D	500	100 μ	-40	10typ		10	30typ		300	1m		μ=20		0.1
TM100-M	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	600 GDO	70 0	50×2	D	500	100 μ	-40	18typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM100-N	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	800 GDO	70 0	50×2	D	500	100 μ	-40	10typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM101-H	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	1200 GDO	70 0	50×2	D	500	100 μ	-40	10typ		10	30typ		300	1m		μ=20		0.1
TM101-M	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	600 GDO	70 0	50×2	D	500	100 μ	-40	18typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM101-N	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	800 GDO	70 0	50×2	D	500	100 μ	-40	10typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM200-H	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	1200 GDO	70 0	100×2	D	1000	100 μ	-40	20typ		10	30typ		300	1m		μ=20		0.1
TM200-M	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	600 GDO	70 0	100×2	D	1000	100 μ	-40	36typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM200-N	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	800 GDO	70 0	100×2	D	1000	100 μ	-40	20typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM201-H	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	1200 GDO	70 0	100×2	D	1000	100 μ	-40	20typ		10	30typ		300	1m		μ=20		0.1
TM201-M	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	600 GDO	70 0	100×2	D	1000	100 μ	-40	36typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM201-N	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	800 GDO	70 0	100×2	D	1000	100 μ	-40	20typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM400-H	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	1200 GDO	70 0	100×4	D	800×4	100 μ	-40	20typ		10	30typ		300	1m		μ=20		0.1
TM400-M	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	600 GDO	70 0	100×4	D	800×4	100 μ	-40	36typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM400-N	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	800 GDO	70 0	100×4	D	800×4	100 μ	-40	20typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM401-H	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	1200 GDO	70 0	100×4	D	800×4	100 μ	-40	20typ		10	30typ		300	1m		μ=20		0.1
TM401-M	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	600 GDO	70 0	100×4	D	800×4	100 μ	-40	36typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TM401-N	トキコ	HV RF PA, PSW	SIT	N	D	800 GDO	70 0	100×4	D	800×4	100 μ	-40	20typ		10	30typ		300	1m		μ=15		0.1
TS300	トキコ	HV RF PA, HV PSW	SIT	N	D	600 GDO	70 0	230	D	3000	200 μ	-40	35typ		10	20typ		300	1m		μ=10		0.1
TS300H	トキコ	HV RF PA, HV PSW	SIT	N	D	1200 GDO	70 0	180	D	3000	200 μ	-40	25typ		10	20typ		300	1m		μ=12		0.1
TS300V	トキコ	HV RF PA, HV PSW	SIT	N	D	1500 GDO	70 0	180	D	3000	200 μ	-40	25typ		10	20typ		300	1m		μ=12		0.1
TX-429D	ソニー	VR	MOS	N		-25 DB		±15m	D	100m	-0.2 μ	-5	-6m		-2	-0.4	-2.5	-1	-1 μ		0.8m	-1	
YTF150	東芝	SW, DDC	MOS	N	E	100 DSX	±20 S	40	D	150	±100n	±20	0.25m	100	2	4	VGS	250 μ	9	11	10	20	
YTF151	東芝	SW, DDC	MOS	N	E	60 DSX	±20 S	40	D	150	±100n	±20	0.25m	60	2	4	VGS	250 μ	9	11	10	20	
YTF152	東芝	SW, DDC	MOS	N	E	100 DSX	±20 S	33	D	150	±100n	±20	0.25m	100	2	4	VGS	250 μ	9	11	10	20	
YTF153	東芝	SW, DDC	MOS	N	E	60 DSX	±20 S	33	D	150	±100n	±20	0.25m	60	2	4	VGS	250 μ	9	11	10	20	

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)													コンプリ メンタリ	外 形	備 考	型 名
Cis (typ) (pF)	Crs (typ) (pF)	Vgs (V)	Vps (V)	NF typ	NF max	f (Hz)	Rg (Ω)	Rps(ON) (max) (Ω)	Vgs (V)	Ip (A)	そ の 他 特 性	測 定 条 件				
					1.7	12G						Ga=8.5dBmin	f=12GHz	339	GSDS	SGH5003E
					1.3	12G						Ga=8dBmin	f=12GHz	339	GSDS	SGH5602E
0.9	0.025	1.5	5	1.6	2.5	800M						Ga=15dBmin/18dBtyp	f=800MHz	340	SG1G2D	SGM2004M
1.1	0.028	1.5	5	1.2	2.0	800M						Ga=18dBmin/22dBtyp	f=800MHz	198/340	SG1G2D/SDG2G1	SGM2006M/P
8000								1.3	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵	TM100-H
8000								0.5	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵	TM100-M
8000								1.0	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵	TM100-N
8000								1.3	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵, Di内蔵	TM101-H
8000								0.5	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵, Di内蔵	TM101-M
8000								1.0	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵, Di内蔵	TM101-N
16000								0.65	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵	TM200-H
16000								0.25	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵	TM200-M
16000								0.50	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵	TM200-N
16000								0.65	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵, Di内蔵	TM201-H
16000								0.25	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵, Di内蔵	TM201-M
16000								0.50	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		314	2素子内蔵, Di内蔵	TM201-N
16000								0.65	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		315	4素子内蔵	TM400-H
16000								0.25	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		315	4素子内蔵	TM400-M
16000								0.50	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		315	4素子内蔵	TM400-N
16000								0.65	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		315	4素子内蔵, Di内蔵	TM401-H
16000								0.25	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		315	4素子内蔵, Di内蔵	TM401-M
16000								0.50	0	2	ton=250ns, toff=300nstyp	VDS=50V, ID=1.5A		315	4素子内蔵, Di内蔵	TM401-N
25000								0.3	0	2	ton=toff=350nstyp	VDS=50V, IDS=1.5A		272	GSD	TS300
25000								0.5	0	2	ton=toff=350nstyp	VDS=50V, IDS=1.5A		272	GSD	TS300H
25000								0.5	0	2	ton=toff=350nstyp	VDS=50V, IDS=1.5A		272	GSD	TS300V
											Rcho=150~300Ω	VDS=-1V, VS=0, VBG=10V		68	Gs+GdSubS	TX-429D
1700	180	0	25					0.055	10	20				230	GSD	YTF150
1700	180	0	25					0.055	10	20				230	GSD	YTF151
1700	180	0	25					0.08	10	20				230	GSD	YTF152
1700	180	0	25					0.08	10	20				230	GSD	YTF153